

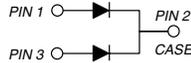
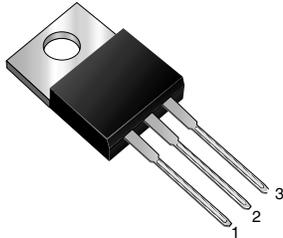


KERSEMI

# MBR1090CT, MBR10100CT

TMBS®

TO-220AB



## FEATURES

- Trench MOS Schottky technology
- Lower power losses, high efficiency
- Low forward voltage drop
- High forward surge capability
- High frequency operation
- Solder bath temperature 275 °C maximum, 10 s, per JESD 22-B106
- Compliant to RoHS directive 2002/95/EC and in accordance to WEEE 2002/96/EC



RoHS  
COMPLIANT

## TYPICAL APPLICATIONS

For use in high frequency rectifier of switching mode power supplies, freewheeling diodes, dc-to-dc converters or polarity protection application

## PRIMARY CHARACTERISTICS

$I_{F(AV)}$	2 x 5.0 A
$V_{RRM}$	90 V, 100 V
$I_{FSM}$	120 A
$V_F$	0.75 V
$T_J$ max.	150 °C

## MECHANICAL DATA

**Case:** TO-220AB

Molding compound meets UL 94 V-0 flammability rating

Base P/N-E3 - RoHS compliant, commercial grade

**Terminals:** Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002 and JESD 22-B102

E3 suffix meets JESD 201 class 1A whisker test

**Polarity:** As marked

**Mounting Torque:** 10 in-lbs maximum

## MAXIMUM RATINGS ( $T_C = 25\text{ °C}$ unless otherwise noted)

PARAMETER	SYMBOL	MBR1090CT	MBR10100CT	UNIT
Maximum repetitive peak reverse voltage	$V_{RRM}$	90	100	V
Working peak reverse voltage	$V_{RWM}$	90	100	V
Maximum DC blocking voltage	$V_{DC}$	90	100	V
Maximum average forward rectified current at $T_C = 105\text{ °C}$ total device per diode	$I_{F(AV)}$	10 5.0		A
Peak forward surge current 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load per diode	$I_{FSM}$	120		A
Non-repetitive avalanche energy at $T_J = 25\text{ °C}$ , $L = 60\text{ mH}$ per diode	$E_{AS}$	60		mJ
Peak repetitive reverse current at $t_p = 2\text{ }\mu\text{s}$ , 1 kHz, $T_J = 38\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ per diode	$I_{RRM}$	0.5		A
Voltage rate of change (rated $V_R$ )	dV/dt	10 000		V/ $\mu\text{s}$
Operating junction and storage temperature range	$T_J, T_{STG}$	- 65 to + 150		°C



ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_C = 25\text{ }^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)						
PARAMETER	TEST CONDITIONS		SYMBOL	MBR1090CT	MBR10100CT	UNIT
Maximum instantaneous forward voltage per diode <sup>(1)</sup>	$I_F = 5.0\text{ A}$	$T_C = 125\text{ }^\circ\text{C}$	$V_F$	0.75	0.85	V
	$I_F = 5.0\text{ A}$	$T_C = 25\text{ }^\circ\text{C}$				
Maximum reverse current per diode at working peak reverse voltage <sup>(2)</sup>			$I_R$	100	6.0	$\mu\text{A}$
				$T_J = 100\text{ }^\circ\text{C}$		mA

**Notes**

<sup>(1)</sup> Pulse test: 300  $\mu\text{s}$  pulse width, 1 % duty cycle

<sup>(2)</sup> Pulse test: Pulse width  $\leq 40\text{ ms}$

THERMAL CHARACTERISTICS ( $T_C = 25\text{ }^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)				
PARAMETER	SYMBOL	MBR1090CT	MBR10100CT	UNIT
Typical thermal resistance per diode	$R_{\theta JC}$	4.4		$^\circ\text{C/W}$

ORDERING INFORMATION (Example)					
PACKAGE	PREFERRED P/N	UNIT WEIGHT (g)	PACKAGE CODE	BASE QUANTITY	DELIVERY MODE
TO-220AB	MBR10100CT-E3/4W	1.87	4W	50/tube	Tube

**RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES**

( $T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)

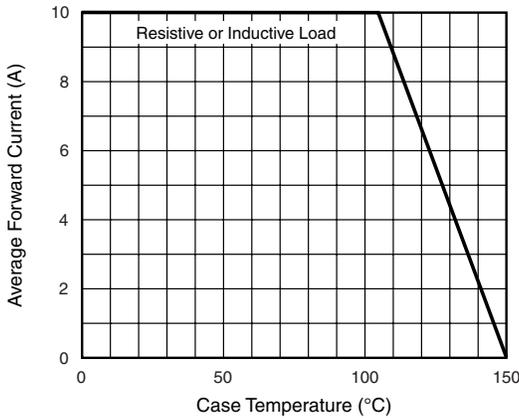


Figure 1. Forward Current Derating Curve

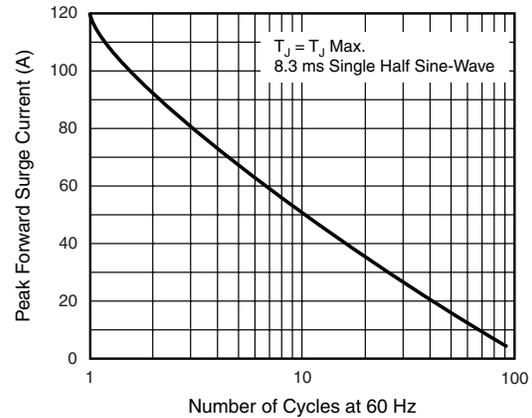


Figure 2. Maximum Non-Repetitive Peak Forward Surge Current Per Diode



KERSEMI

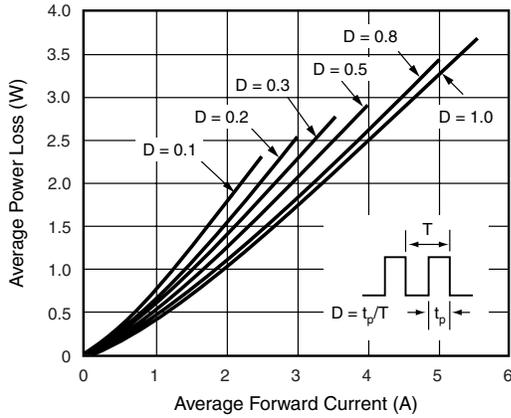


Figure 3. Forward Power Loss Characteristics Per Diode

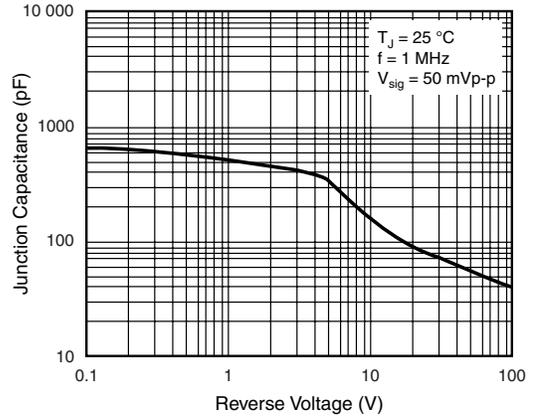


Figure 6. Typical Junction Capacitance Per Diode

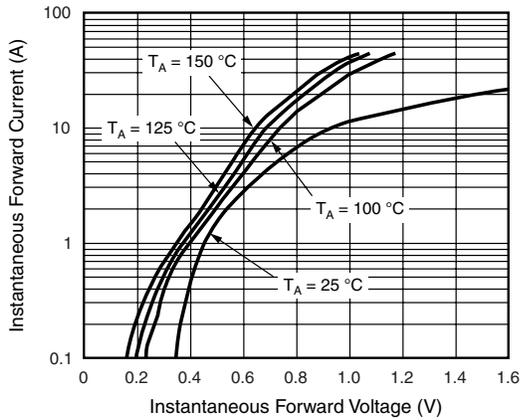


Figure 4. Typical Instantaneous Forward Characteristics Per Diode

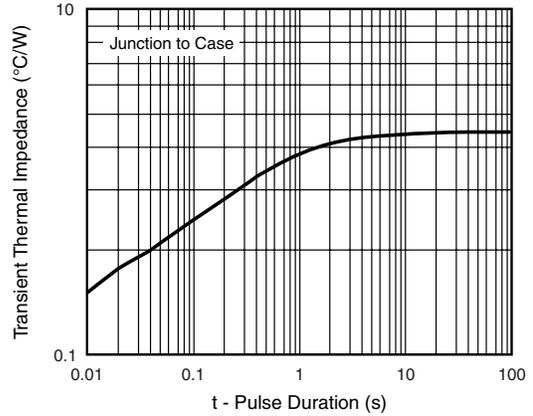


Figure 7. Typical Transient Thermal Impedance Per Diode

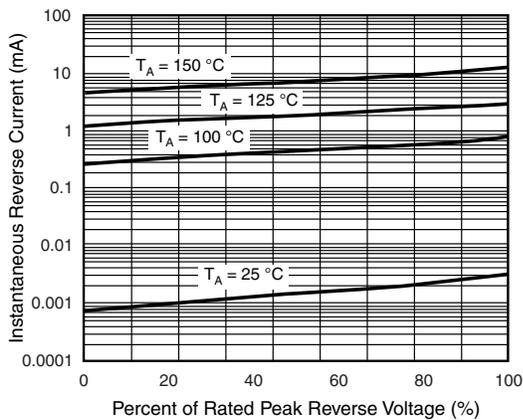
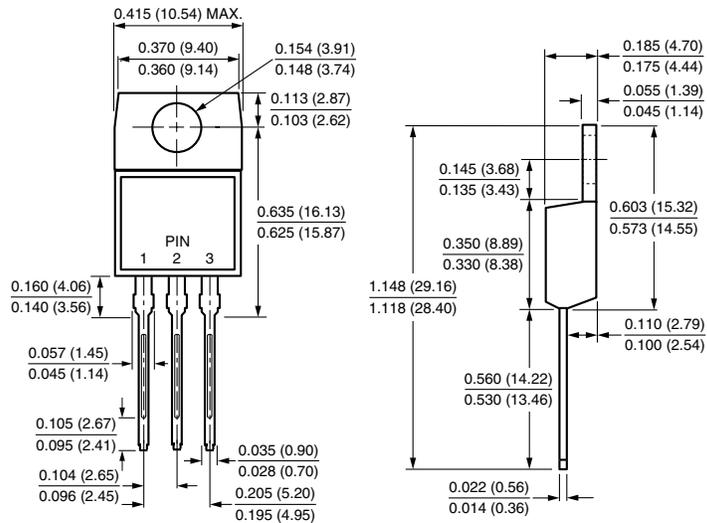


Figure 5. Typical Reverse Characteristics Per Diode

**PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS** in inches (millimeters)

**TO-220AB**





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.